
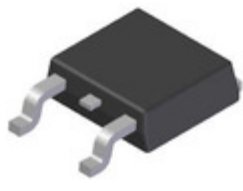
	<p>DMN60H3D5SK3-13</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN60H3D5SK3-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.8A TO252</p> <p>Datenblätter:  DMN60H3D5SK3-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







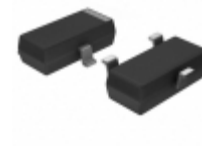

Spezifikationen

Teilenummer	DMN60H3D5SK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	354pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.8A (Tc) 41W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

DMN60H3D5SK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN60H3D5SK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN60H3D5SK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN60H3D5SK3-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN6075S-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>	 <p>DMN60H080DS-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23</p>	 <p>DMN6075SD-7 DIODES DMN6075SD-7 DIODES</p>	 <p>DMN6075S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>
 <p>DMN60H080DS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23</p>	 <p>DMN6140LQ DIODES DMN6140LQ DIODES</p>	 <p>DMN6140LQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT23</p>	 <p>DMN60H4D5SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 2.5A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN60H3D5SK3-13 Diodes Incorporated	DMN60H3D5SK3-13 Datenblatt	DMN60H3D5SK3-13-Datenblätter	DMN60H3D5SK3-13 PDF	Diodes Incorporated DMN60H3D5SK3-13
DMN60H3D5SK3-13 Electronic	DMN60H3D5SK3-13-Komponenten	DMN60H3D5SK3-13-Verteiler	DMN60H3D5SK3-13-Bild	DMN60H3D5SK3-13-Teil
DMN60H3D5SK3-13 Preis	DMN60H3D5SK3-13 Hersteller	DMN60H3D5SK3-13 Bild	DMN60H3D5SK3-13 Aktie	DMN60H3D5SK3-13 Inventar
DMN60H3D5SK3-13 Neu	DMN60H3D5SK3-13 Original	DMN60H3D5SK3-13 garantiert	DMN60H3D5SK3-13 RFQ	DMN60H3D5SK3-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited